НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ім І.Сікорського

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ КАФЕДРА КЕОА

3BIT

ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3

3 КУРСУ

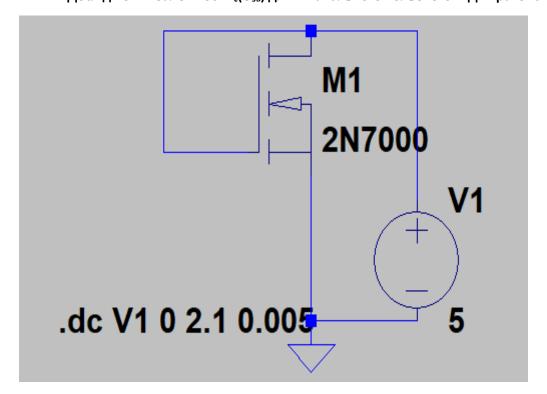
«Аналогова електроніка»

ТЕМА РОБОТИ: «Дослідження польового МДН транзистора з індукованим n-каналом»

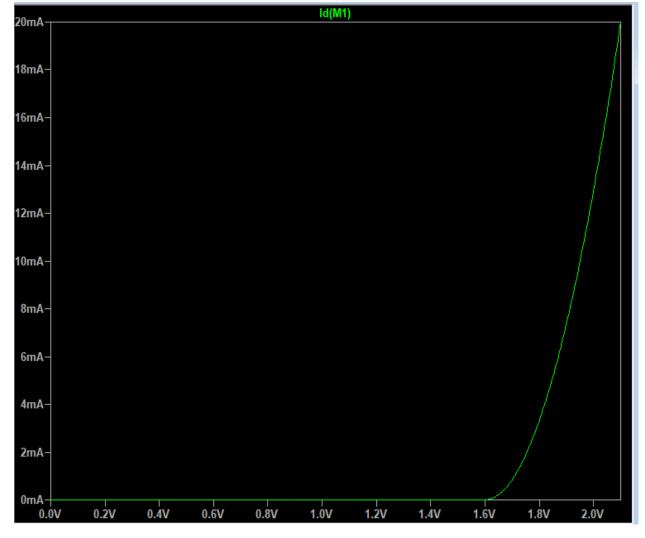
ВИКОНАВ: студент гр. Дк-61 Сидорчук Максим

ПЕРЕВІРИВ: доцент Короткий Є.В

1. Дослідження залежності $I_c(U_{\scriptscriptstyle 3B})$ для n-канального польового МДН транзистора 2N7000



одержуємо наступний графік залежності I_c(U_{зв}):



ТАблиця залежності Струму каналу від напруги затвор-виток. $I_c(U_{3B})$:

Uзв, V	Ic, A
0,20	0,000000000000241
0,40	0,000000000000440
0,60	0,000000000000639
0,80	0,000000000000839
1,00	0,00000000001040
1,20	0,00000000001242
1,40	0,00000000001439
1,60	0,000005
1,80	0,003309
2,00	0,013050
2,20	0,028461

Розрахунок порогової напруги Un:

U3B	Ic
1.8386878V	4.7009885mA
2.083371V	18.723306mA

$$Ic2=4\cdot Ic1=b/2(U3B2-U\pi)2$$

$$4.7009885 \text{M} = 500 * b * (1.8386878 - Up)^2$$

$$18.723306 M = 500 * b * (2.083371 - Up)^{2}$$

3 формул наведених на попередньому кроці можна визначити порогову напругу і параметр транзистору b

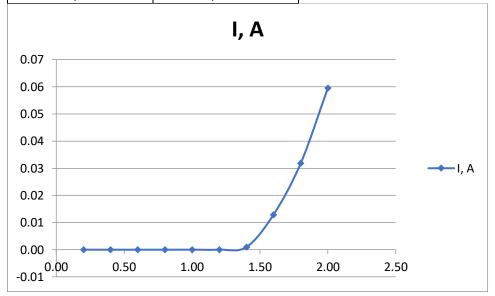
Uп=2U3в1-U3в2=2*1.8386878-2.083371=1.5940046

b=0.15704 м

Uзв V	Струм стоку Ltspice	Струм стоку з формули	Похибка%
1,60	0,000005	0,000003	45,65
1,80	0,003309	0,003332	0,69
2,00	0,013050	0,012943	0,82
2,20	0,028461	0,028835	1,31

Реальні вимірювання

Изв	lc	
0,20	0,00	
0,40	0,00	
0,60	0,00	
0,80	0,0000018	
1,00	0,00000361	
1,20	0,00001553	
1,40	0,000955	
1,60	0,0129	
1,80	1,80 0,0318	
2,00	0,0595	



Розрахунок порогової напруги Un:

Uзв	Ic
1.6V	12,9mA
2V	59,5mA

Іс1=b/2(Изв1-Ип)2

$$Ic2=4·Ic1=b/2(U3β2-Uπ)2$$

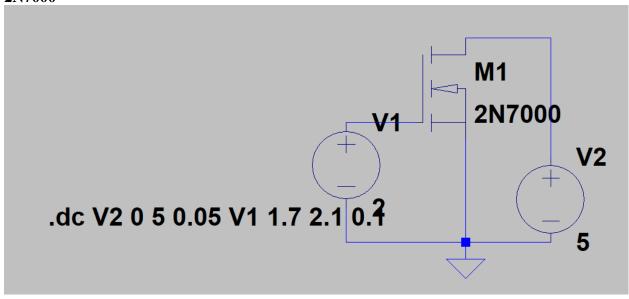
$$12,9M = 500 * b * (1.6 - Up)^2$$

$$59.5 \text{M} = 500 * b * (2.083371 - Up)^2$$

3 формул наведених на попередньому кроці можна визначити порогову напругу і параметр транзистору b

b=0.16125 м

2. Дослідження залежності $I_c(U_{\mbox{\tiny BC}})$ для n-канального польового МДН транзистора 2N7000

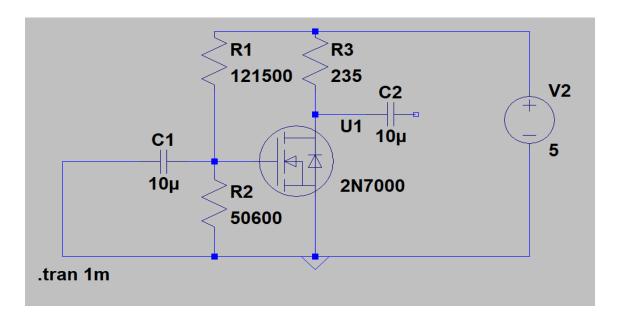


Варіюючи напругу Uзв (джерело V1) в діапазоні від 1.7 до 2.1 В з кроком 0.1 В та варіюючи напругу Uвс (джерело V2) в діапазоні від 0 до 5 В з кроком 0.05 В, визначте залежність $I_c(U_{\infty})$ для різних значень напруг на затворі, одержавши сімейство вихідних статичних характеристик транзистора:



3. Дослідження підсилювача з загальним витоком на польовому МДН транзисторі 2N7000

R1	121500,00	Om
R2	50600,00	Om
R3	235,00	Om
C1	10,00	uF
C2	10,00	uF



3.2 Робоча точка при відсутності вхідного сигнулу

Симуляція:

Uзв0=1.47 V

Uвс0=4.307 V

Ic0=2.949 mA

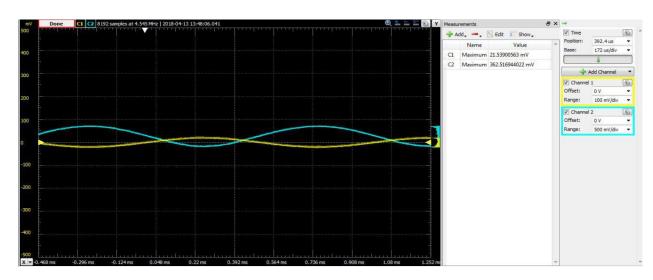
Реальні вимірювання:

Uзв0= 1,463V

Uвс0= 3,67 V

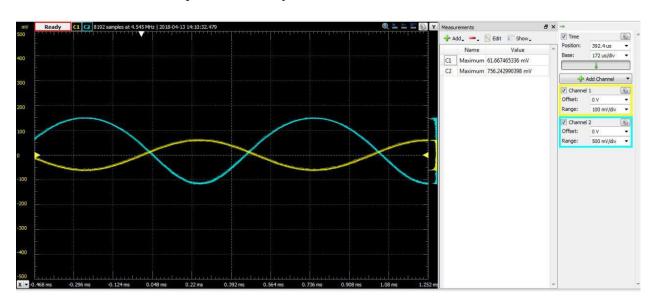
Ic0 = 5,67mA

3.3 Напругу вхідного сигналу амплітудою 20 мВ та частотою 1 КГц - жовтий графік.



ВИХ	ВХ	Ки_практичне
0,36200	0,02153	16,81

3.4 Визначення максимальної величини змінної напруги на вході, при якій схема виходить з лінійного режиму підсилення і починають виникати нелінійні спотворення сигналу на виході. U=60 mV



3.5

R1	121500,00	Om
R2	55250,00	Om
R3	235,00	Om
C1	10,00	
C2	10,00	uF

Uзв1=1,556 V

ΔUзв=0,093 V

Ic1=11,51 мА

 Δ Ic=5,84 мА

Визначимо передаточну провідність за формулою gm=ΔIc/ΔUзв

 g_m =0,0628 м

 $K_u = g_m * R3 = 0.0628 * 235 = 14.758$

Передаточну провідність також можна розрахувати за формулою gm=b·(Uзв0-Uп)

 g_m =0.16125 M * (1.47-1.2) = 0.044

 $K_u = g_m * R3 = 0.044 * 235 = 10.34$

Висновок: було досліджено схему на біполярному транзисторі із індукованим п-каналом із загальним витоком. Спочатку було складена схема у режимі великого

сигналу, відсутній вхідний сигнал, для визначення точок спокою. Потім подали малий змінний сигнал який ми підсилюємо, виміряли амплітуди вхідного і вихідного сигналу і визначили коеф. Підсилення за напругою і порівняли його з розрахованим значенням.